

性能特点

- 频率范围: 2.7GHz~3.0GHz
- 功率增益: >40dB
- 饱和输出功率: > 51dBm
- 功率附加效率: 50%
- +28V /-5V

产品简介

HX2730P150WM是一种GaN功率放大器模块，其频率范围为2.7GHz~3.0GHz，功率增益大于40dB，饱和输出功率大于 51dBm，工作电压 V_{DS} :+28V, V_{GS} : -5V。

电参数 (T_C = +25°C, V_{DS} =+28V, V_{GS} =-5V)

| 指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------|---------------------|-----|-----|-----|
| 频率范围 | 2.7~3.0 | | | GHz |
| 功率增益 | 40 | 42 | | dB |
| 增益平坦度 | | | ±1 | dB |
| 饱和输出功率 | 51 | 52 | | dBm |
| 功率附加效率 | 50 | 58 | | % |
| 外形尺寸 | 45.0mm×25.0mm×5.3mm | | | |

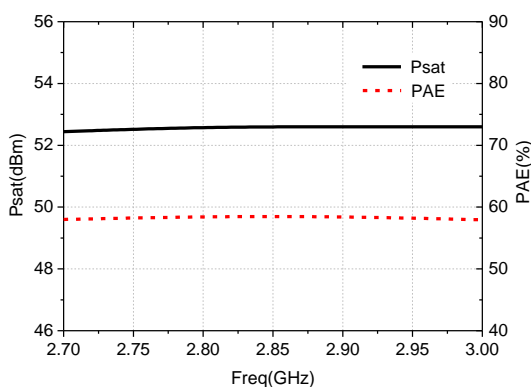
注：射频测试条件: V_{DS} =+28V, V_{GS} =-5V, P_{in} =+10dBm, 脉宽: 3ms, 占空比: 30%; 先加栅压, 后加漏压。

极限参数

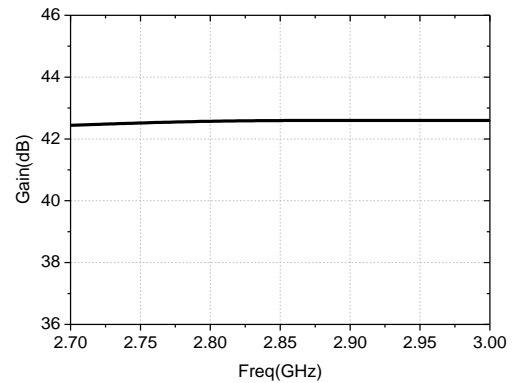
| | |
|---------|--------------|
| 最大漏源正电压 | +36V |
| 最高输入功率 | +14dBm |
| 储存温度 | -55°C~+120°C |
| 使用温度 | -45°C~+70°C |

典型曲线

饱和输出功率/效率 vs. 频率



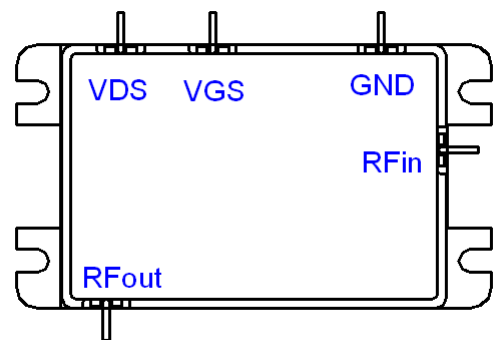
功率增益 vs. 频率



外形尺寸

HX2730P150WM型GaN放大器模块的外形尺寸及固定孔位置: 见封装。

引出端排列图



| 引脚号 | 符号 | 功能 |
|-----|------------|---------|
| 1 | V_{GS} | 栅源电源端口 |
| 2 | RF_{in} | 射频信号输入端 |
| 3 | RF_{out} | 射频信号输出端 |
| 4 | V_{DS} | 漏源电源端口 |
| 5 | GND | 接地 |

使用方法与注意事项

使用时将器件紧贴盒体底部用螺丝固定。特别提示, 该器件为静电敏感器件, 操作时请严防静电。

注: 模块外形尺寸及性能指标可按用户要求定制。

封装尺寸:

